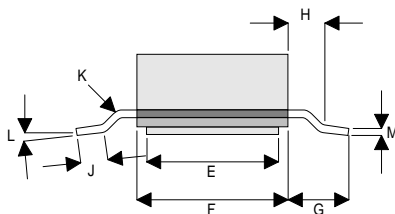
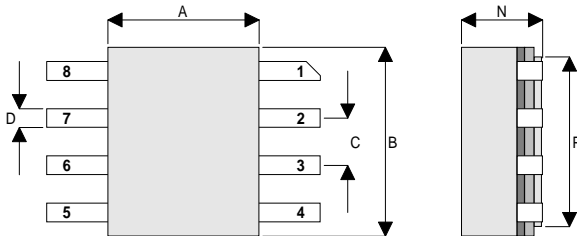


MECHANICAL DATA



SO8 PACKAGE

- PIN 1 – SOURCE
- PIN 2 – DRAIN
- PIN 3 – DRAIN
- PIN 4 – SOURCE
- PIN 5 – SOURCE
- PIN 6 – GATE
- PIN 7 – GATE
- PIN 8 – SOURCE

Dim.	mm	Tol.	Inches	Tol.
A	4.06	±0.08	0.160	±0.003
B	5.08	±0.08	0.200	±0.003
C	1.27	±0.08	0.050	±0.003
D	0.51	±0.08	0.020	±0.003
E	3.56	±0.08	0.140	±0.003
F	4.06	±0.08	0.160	±0.003
G	1.65	±0.08	0.065	±0.003
H	0.76	+0.25 -0.00	0.030	+0.010 -0.000
J	0.51	Min.	0.020	Min.
	1.02	Max.	0.040	Max.
K	45°	Max.	45°	Max.
L	0°	Min.	0°	Min.
	7°	Max.	7°	Max.
M	0.20	±0.08	0.008	±0.003
N	2.18	Max.	0.086	Max.
P	4.57	±0.08	0.180	±0.003

**GOLD METALLISED
MULTI-PURPOSE SILICON
DMOS RF FET
5W – 28V – 1GHz
SINGLE ENDED**

FEATURES

- SIMPLIFIED AMPLIFIER DESIGN
- SUITABLE FOR BROAD BAND APPLICATIONS
- VERY LOW C_{rss}
- SIMPLE BIAS CIRCUITS
- LOW NOISE
- HIGH GAIN – 13 dB MINIMUM

APPLICATIONS

- HF/VHF/UHF COMMUNICATIONS
from 1 MHz to 1 GHz

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_{case} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated)

P_D	Power Dissipation	30W
BV_{DSS}	Drain – Source Breakdown Voltage *	65V
BV_{GSS}	Gate – Source Breakdown Voltage*	±20V
$I_{D(sat)}$	Drain Current	2A
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to 150°C
T_j	Maximum Operating Junction Temperature	200°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25°C unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
BV _{DSS} Drain-Source Breakdown Voltage	V _{GS} = 0 I _D = 10mA	65			V
I _{DSS} Zero Gate Voltage Drain Current	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0			2	mA
I _{GSS} Gate Leakage Current	V _{GS} = 20V V _{DS} = 0			1	μA
V _{GS(th)} Gate Threshold Voltage*	I _D = 10mA V _{DS} = V _{GS}	1		5	V
g _{fs} Forward Transconductance*	V _{DS} = 10V I _D = 0.4A	0.36			S
G _{PS} Common Source Power Gain	P _O = 5W	13			dB
η Drain Efficiency	V _{DS} = 28V I _{DQ} = 0.4A	40			%
VSWR Load Mismatch Tolerance	f = 1GHz	20:1			—
C _{iss} Input Capacitance	V _{DS} = 0V V _{GS} = -5V f = 1MHz			24	pF
C _{oss} Output Capacitance	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0 f = 1MHz			12	pF
C _{rss} Reverse Transfer Capacitance	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0 f = 1MHz			1	pF

* Pulse Test: Pulse Duration = 300 μs , Duty Cycle ≤ 2%

THERMAL DATA

R _{THj-case}	Thermal Resistance Junction – Case	Max. 6°C / W
-----------------------	------------------------------------	--------------

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TT Electronics:](#)

[D2020UK](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9